

# PNP SILICON PLANAR MEDIUM POWER HIGH GAIN TRANSISTOR

## ZTX788A

PROVISIONAL DATASHEET ISSUE 2 – SEPTEMBER 94

### FEATURES

- \* 15 Volt  $V_{CE0}$
- \* Gain of 200 at  $I_C=2$  Amps
- \* Very low saturation voltage



E-Line  
TO92 Compatible

### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	$V_{CBO}$	-20	V
Collector-Emitter Voltage	$V_{CEO}$	-15	V
Emitter-Base Voltage	$V_{EBO}$	-5	V
Peak Pulse Current	$I_{CM}$	-10	A
Continuous Collector Current	$I_C$	-3	A
Practical Power Dissipation*	$P_{totp}$	1.5	W
Power Dissipation at $T_{amb}=25^\circ\text{C}$ derate above $25^\circ\text{C}$	$P_{tot}$	1 5.7	W mW/ $^\circ\text{C}$
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +200	$^\circ\text{C}$

\*The power which can be dissipated assuming the device is mounted in a typical manner on a P.C.B. with copper equal to 1 inch square minimum

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$ )

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-20	-30		V	$I_C=-100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	-15	-20		V	$I_C=-10\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5	-8.5		V	$I_E=-100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$			-0.1 -10	$\mu\text{A}$ $\mu\text{A}$	$V_{CB}=-10\text{V}$ $V_{CB}=-10\text{V}, T_{amb}=100^\circ\text{C}$
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$			-0.1	$\mu\text{A}$	$V_{EB}=-4\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		-0.025 -0.25 -0.28	-0.035 -0.32 -0.33	V V V	$I_C=0.1\text{A}, I_B=2\text{mA}^*$ $I_C=2\text{A}, I_B=20\text{mA}^*$ $I_C=3\text{A}, I_B=200\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		-0.85	-1.0	V	$I_C=2\text{A}, I_B=20\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		-0.8		V	$I_C=2\text{A}, V_{CE}=-3\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	$h_{FE}$	300 250 200 80		800		$I_C=10\text{mA}, V_{CE}=1\text{V}^*$ $I_C=1\text{A}, V_{CE}=1\text{V}^*$ $I_C=2\text{A}, V_{CE}=1\text{V}^*$ $I_C=10\text{A}, V_{CE}=2\text{V}^*$

# ZTX788A

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ )

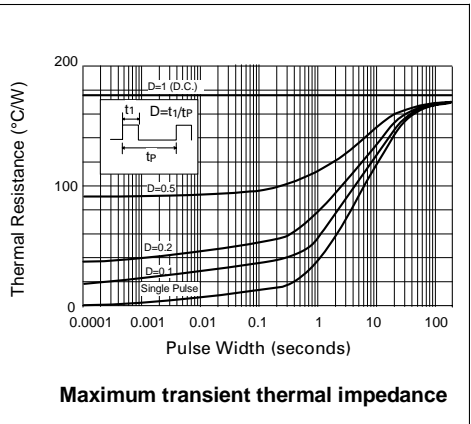
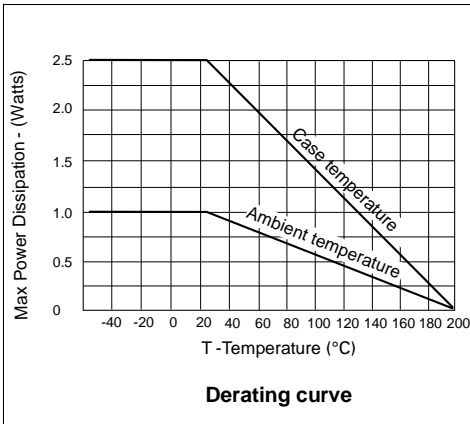
PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Transition Frequency	$f_T$	100	150		MHz	$I_C = -50\text{mA}$ , $V_{CE} = -5\text{V}$ $f = 50\text{MHz}$
Output Capacitance	$C_{obo}$		30	60	pF	$V_{CE} = -10\text{V}$ , $f = 1\text{MHz}$
Switching Times	$t_{on}$ $t_{off}$		40 500		ns ns	$I_C = -500\text{mA}$ , $I_{B1} = -50\text{mA}$ $I_{B2} = -50\text{mA}$ , $V_{CC} = -10\text{V}$

\*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 $\mu\text{s}$ . Duty cycle  $\leq 2\%$

## THERMAL CHARACTERISTICS

PARAMETER	SYMBOL	MAX.	UNIT
Thermal Resistance: Junction to Ambient <sub>1</sub>	$R_{th(j-amb)1}$	175	$^{\circ}\text{C/W}$
Junction to Ambient <sub>2</sub>	$R_{th(j-amb)2} \dagger$	116	$^{\circ}\text{C/W}$
Junction to Case	$R_{th(j-case)}$	70	$^{\circ}\text{C/W}$

$\dagger$  Device mounted on P.C.B. with copper equal to 1 sq. Inch minimum.



## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9